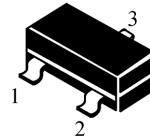


GMA733

SOT-23

1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR



■MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$) 最大額定值

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	-60	Vdc
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	-50	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	-5.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	I_c	-150	mA
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P_C	200	mW
Junction Temperature 結溫	T_j	150	°C
Storage Temperature Range 儲存溫度	T_{stg}	-55~150	°C

■DEVICE MARKING 打標

GMA733(A733LT1)=CS
HFE:120-220 200-475



GMA733

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

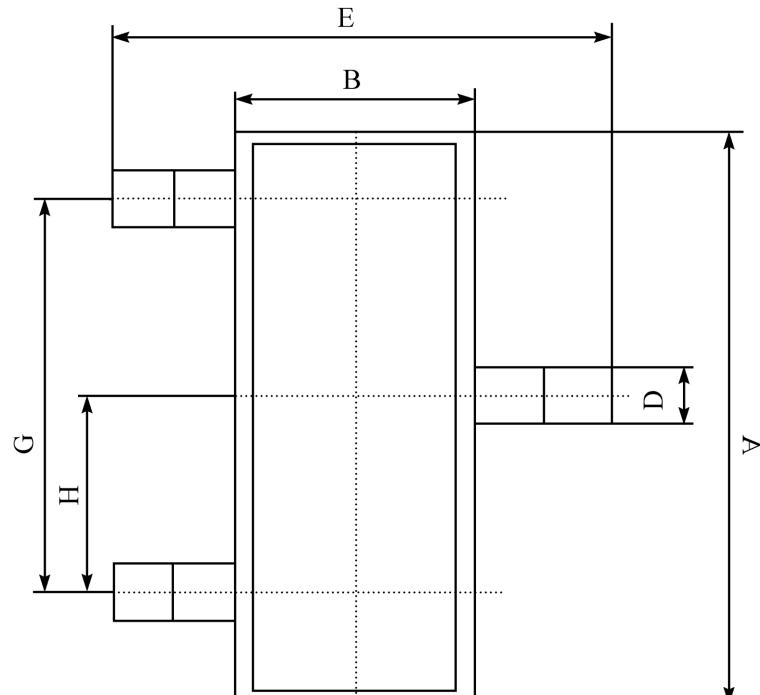
($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明, 溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=-60\text{V},$ $I_E=0$	—	—	-0.1	μA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=-5\text{V},$ $I_C=0$	—	—	-0.1	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(\text{BR})\text{CBO}}$	$I_C=-5\ \mu\text{A}$	-60	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	$I_C=-1.0\text{mA}$	-50	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(\text{BR})\text{EBO}}$	$I_E=-50\ \mu\text{A}$	-5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	H_{FE}	$V_{\text{CE}}=-6\text{V},$ $I_C=-1\text{mA}$	120	—	475	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{\text{CE}(\text{sat})}$	$I_C=-100\text{mA},$ $I_B=-10\text{mA}$	—	—	-0.3	V
Base-Emitter Saturation 基極-發射極電壓	V_{BE}	$V_{\text{CE}}=-6\text{V},$ $I_C=-1\text{mA}$	—	—	-0.68	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{\text{CE}}=-6.0\text{V},$ $I_C=-10\text{mA}$	50	—	—	MHz

GMA733

■DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



序號	數值及公差
A	2.90 ± 0.10
B	1.30 ± 0.10
C	1.00 ± 0.10
D	0.40 ± 0.10
E	2.40 ± 0.20
G	1.90 ± 0.10
H	0.95 ± 0.05
J	0.13 ± 0.05
K	$0.00-0.10$
M	≥ 0.2
N	0.60 ± 0.10
P	$7 \pm 2^\circ$

